

【第1表】 2SA756

最大定格(Ta=25℃) 2SA756			
項 目	記号	2SA756	単位
コレクター・ベース電圧	V _{CB0}	-100	V
コレクター・エミッター電圧	V _{CE0}	-80	V
エミッター・ベース電圧	V _{EB0}	-6	V
コレクター電流	I _C	-6	A
せん頭コレクター電流	I _{C(peak)}	-8	A
許容コレクター損失*	P _C	50	W
接合部温度	T _j	150	℃
保存温度	T _{stg}	-65~+150	℃

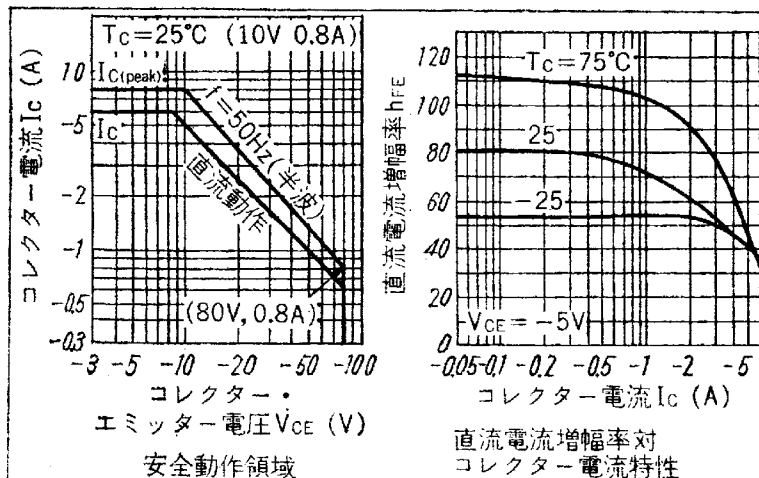
*T_C=25℃における許容値

電気的特性(Ta=25℃)

項 目	記号	測定条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクター・エミッター破壊電圧	V _{(BR)CEO}	I _C =-50mA, R _{BE} =∞	-80	—	—	V
エミッター・ベース破壊電圧	V _{(BR)EBO}	I _E =-5mA, I _C =0	-6	—	—	V
コレクター遮断電流	I _{CBO}	V _{CB} =-30V, I _E =0	—	—	-1	mA
直流電流増幅率*	h _{FE}	V _{CE} =-5V, I _C =-1A	35	—	200	
		I _C =-5A	22	50	—	
ベース・エミッター電圧	V _{BE}	V _{CE} =-5V, I _C =-1A	—	—	-1.0	V
コレクター・エミッター飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =-5A, I _E =-1A	—	—	-1.5	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =-5V, I _C =-1A	—	20	—	MHz

*2SA756はh_{FE}(V_{CE}=-5V, I_C=-1A)の値により下記のように3区分し、現品にそれぞれ①、②、③と表示してあります。 ①35~70, ②60~120, ③100~120

【第26図】 2SA756



【第2表】 2SC1030

最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$) 2SA1030			
項 目	記号	2SC1030	単位
コレクター・ベース電圧	V_{CB0}	150	V
コレクター・エミッター電圧	V_{CE0}	80	V
エミッター・ベース電圧	V_{EB0}	6	V
コレクター電流	I_C	6	A
せん頭コレクター電流	$i_{C(\text{peak})}$	10	A
許容コレクター損失*	P_C	50	W
接合部温度	T	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値

電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記号	測定条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクター・エミッター破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	80	—	—	V
エミッター・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	V
コレクター遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=30\text{V}, I_E=0$	—	—	1	mA
直流電流増幅率*	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	35	80	200	
		$I_C=5\text{A}$	22	50	—	
ベース・エミッター電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	—	—	1.0	V
コレクター・エミッター飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=5\text{A}, I_E=1\text{A}$	—	0.8	1.5	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	—	10	—	MHz
2次破壊電流	I_X	$V_{CE}=50\text{V}, f=50\text{Hz}$	4.5	—	—	A

(半波)

* **2SC1030**は $h_{FE}(V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A})$ の値により下記のように①、②、③と区分してあります
 ①35~70, ②60~120, ③100~200

【第27図】 2SC1030

